

## 平成24年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[電磁気学]

1. 真空の3次元  $xyz$  空間中で、 $xy$  平面 ( $z=0$ ) の周りの厚み  $2d$  の領域 ( $-\infty < x < \infty$ 、 $-\infty < y < \infty$ 、 $|z| \leq d$ ) に電荷が電荷密度  $\rho$  ( $\rho > 0$ ) で均一に分布している。真空の誘電率を  $\varepsilon_0$  とする。

【30点】

- (1)  $z < -d$ 、 $-d \leq z \leq d$ 、 $d < z$  の各領域における  $z$  軸方向の電場  $E(z)$  を求めよ。
- (2) 縦軸を  $E(z)$ 、横軸を  $z$  として、 $E(z)$  の概形をグラフに描け。
- (3)  $z < -d$ 、 $-d \leq z \leq d$ 、 $d < z$  の各領域における電位  $V(z)$  を求めよ。ただし、 $z=0$  において  $V(0)=0$  とする。
- (4) 縦軸を  $V(z)$ 、横軸を  $z$  として、 $V(z)$  の概形をグラフに描け。

2. 図1のように、半径 $a$ および半径 $b$  ( $a < b$ )、長さが $L$ で、厚みが無視できる2つの導体円筒が真空中にあり、中心軸が一致するように置かれている。真空の誘電率を $\epsilon_0$ とする。

【20点】

- (1) この同心導体円筒をコンデンサーとして用いる。コンデンサーの静電容量 $C$ を求めよ。 $L \gg a, b$ であり円筒の端の影響は考慮しなくてよいとする。

図2のように、この導体円筒間の領域を電気伝導率 $\sigma$ の物質で充たす。

- (2) 外側と内側の円筒間の電気抵抗 $R$ を求めよ。

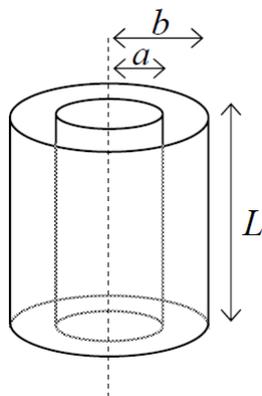


図1

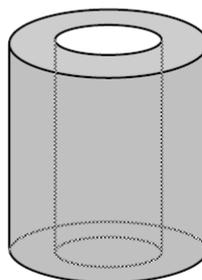


図2

3. 真空中にエポナイト（絶縁体）でできた厚みの無視できる球殻（半径  $a$ 、質量  $m$ ）がある。球殻の表面には一様に電荷が分布しており（面電荷密度  $\rho$ ）、電荷は球殻上に固定されている。球殻の中心を原点として  $xyz$  座標軸をとり、空間的には一様で時間変化する磁束密度  $\mathbf{B}(t)$  を印加すると、帯電した球殻が回転した。時刻  $t$  ( $t \geq 0$ ) における磁束密度は  $\mathbf{B}(t) = \left( 0, 0, B_0(1 - e^{-\frac{t}{t_0}}) \right)$  で与えられる。  $B_0$ 、  $t_0$  はそれぞれ正の定数である。球殻の存在によって磁束密度  $\mathbf{B}(t)$  が変化することはないとする。また、球殻の回転によって発生する磁場の効果も無視できるとする。真空の誘電率を  $\epsilon_0$ 、透磁率を  $\mu_0$  とする。

【 2 5 点】

- (1) 球殻上の点  $(x, y, z)$  で生じる誘導電場の大きさを求めよ。球殻上の点の座標  $(x, y, z)$  は、極座標表示を用いて、  $(x, y, z) = (a \sin \theta \cos \varphi, a \sin \theta \sin \varphi, a \cos \theta)$  と表せることを用いてもよい。
- (2) 時刻  $t$  において誘導電場が帯電球殻に与える力の原点に関するモーメントの総和の大きさ  $N(t)$  を求めよ。
- (3) 時刻  $t$  における帯電球殻の回転の向きと角速度  $\omega(t)$  を求めよ。ただし、球殻の中心軸に関する慣性モーメントは  $I = \frac{2}{3}ma^2$  である。

4.  $xyz$  空間において、 $z < 0$  の領域は真空、 $z \geq 0$  の領域は誘電率  $\varepsilon = 12\varepsilon_0$ 、透磁率  $\mu = 3\mu_0$  の一様な媒質で満たされているとする。 $z < 0$  の領域（真空）から  $z$  軸正方向に伝搬する角振動数  $\omega_0$  の平面電磁波が、 $z \geq 0$  の領域（媒質）へ入射する。入射する電磁波の電場成分を  $\mathbf{E}_0 = (E_0 \cos(k_0 z - \omega_0 t), 0, 0)$ 、波数ベクトルを  $\mathbf{k}_0 = (0, 0, k_0)$ 、真空の誘電率を  $\varepsilon_0$ 、透磁率を  $\mu_0$  とする。一般に誘電率  $\varepsilon$ 、透磁率  $\mu$  の媒質中を電磁波が伝搬する速さは  $\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$  で与えられ、電磁波の電場  $\mathbf{E}$  と磁場  $\mathbf{H}$  の間には  $\frac{|\mathbf{H}|}{|\mathbf{E}|} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}$  の関係がある。また一般に、異なる媒質の界面において、 $\mathbf{E}$  および  $\mathbf{H}$  の界面に平行な成分は連続である。

【25点】

- (1) 入射波の磁場成分  $\mathbf{H}_0$  を求めよ。
- (2) 反射波の電場成分  $\mathbf{E}_R$  および磁場成分  $\mathbf{H}_R$  を求めよ。
- (3) 透過波の電場成分  $\mathbf{E}_T$  および磁場成分  $\mathbf{H}_T$  を求めよ。
- (4) 電磁波の反射率  $R = S_R / S_0$  および透過率  $T = S_T / S_0$  を求めよ。ただし、 $S_0$ 、 $S_R$ 、 $S_T$  は入射波、反射波、透過波のポインティングベクトル ( $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ ) の大きさである。

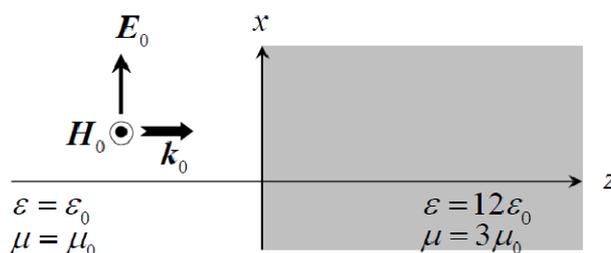


図 3